4

REFAU

437 <u>902</u> - 227

5387 E

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS PRODUCTION

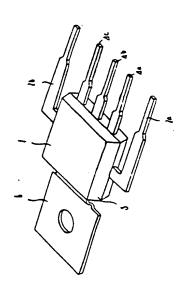
(11) Kokai No. 53-68992 (43) 6.19.1978 (19) JP (21) Appl. No. 51-145288 (22) 12.2.1976

(71) MITSUBISHI DENKI K.K. (72) SHINZOU YAMASHITA

(52) JPC: 99(5)J4;99(5)J40;99(5)C21 (51) Int. Cl². H01L31 12 : H01L23 48

PURPOSE: To reduce the packaging area of a photo coupler by leading out plural output terminals from one of four side faces, respectively one input terminal from the two side faces in adjacent thereto and further a heat radiating fin from the remaining one side face on a plane intersecting perpendicularly to the four side faces of a resin sealed rectangular parallelopiped in which a light emitting element and a photo detector are sealed.

CONSTITUTION: A heat radiating fin 6 is connected to one of the side faces of a photo coupler 1 in which a light emitting element and a photo detector are sealed, and output terminals 4a thru 4c are led out in linear form from the side faces opposing thereto. Also, input terminals 2a, 2b are led out respectively from the two side faces intersecting perpendiculary to these. These are bent in the direction opposite from the heat radiating fin 6 and are led out by being arrayed parallel with the output terminals 4a thru 4c on the same plane. Then, the input and output terminals are all on the same plane and therefore they may be packaged in array on one straight line on a printed base plate, and packaging area is reduced.



(19日本国特許庁

印特許出願公開

公開特許公報

昭53-68992

\$i Int. Cl.² H 01 L 31·12

4>

H 01 L 23 48

識別記号

昭51(1976)12月2日

52日本分類 99(5) **J** 4 99(5) J 40

99(5) C 21

庁内整理番号 7377-57 6655-57 7357-57 43公開 昭和53年(1978)6月19日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

領半導体装置およびその製造方法

力!!!! 頤 人

電機株式会社北伊丹製作所內

須特 顯 昭51-145288

九出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2

番3号

79発 明 者 山下信三

••

排代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱

朝 細 有

1. 発明の名称

22出

半導体装置かよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 発光素子と受光素子とを組合わせ、光を介して発光素子から受光素子へ電気信号を伝達するホトカプラにおいて、上記発光素子と受光業子を對入する電方体の樹脂對止の4つの側面と直交する平面上に、4つの側面の1つから複数の出力端子を出し、上記1つの側面に顕接する2つの側面が5 大41 個づつの入力端子を出し、長りの1つの側面から放熱フィンを出したことを特徴とする半線体接触。

(2)入力端子を出力端子と何じ方向に失々90°mmけ、 入力端子と出力端子を一級上に並べたことを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

(3) 発光素子(または受光素子)を装着した素子の袋者部と素子の入力(または出力)端子を一体に形成した第1のフレームと、受光素子(または発光素子を装着した素子の袋者部と素子の出力(

または入力)端子と放無フィンとを一体に形成した第2のフレームとを準備し、これら第1、第2のフレームを重合して発光果子と受光果子とを位置決めし、上記発光素子と受光果子部分を被励でモールドした後上記各端子及び放動フィンを摂むてフレームを切断除去するようにしたことを特数とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

との発明は、電気により電磁放(赤外、可視あるいは無外線を含む、以下光と呼ぶ)を発生する 発光素子と、との電磁波を受けてその特性が変化 する受光果子(ホトダイオード、ホトトランジスタ、ホトサイリスタ、あるいは太陽電池等)とを 組合わせて、電気信号を一度光信号に変換し、再 歴電気信号にもどす光結合半導体果子(一般にホトカブラ photo coupler と呼ばれている)の改良 構造に関するものである。

第1図は従来のホトカブラの斜複図、第2図は その平面図(a)、正面図(b)、側面図(c)である。図に かいて、(l)はホトカブラ、(2a)(2b)は入力 強子、(3)は無望鉄端子、(4a)(4b)(4c)は出力強子、(5)は割止用制脂である。とのような従来のホトカブラはジュアルライン(Dual in line)形状をしている。とのようなジュアルラインの形状では2列のビン関係はかよそ%インチであり、3本のビンの関係は%インチである。とのためとのホトカブラで衝費できる電力損失はかよそ0.25世であり、とれ以上消費させるととはできない。またビンが2列に並んでいるため、ブリント基板に実装する場合、大きな実装面積が必要であるという不具合があつた。

との発明は上記のような従来のホトカブラの欠点を飲去するためになされたもので、実製面積を 小さくし、入出力間の絶縁耐力を向上させ、なら に大きな電力を情受できるホトカブラを提供する ものである。以下との発明の一実施例を結る図 至第6図により説明する。図中第1図、第2図 同一符号は相当する部分を示すものであり、説明 を始する。

第3回はこの発明の一典施例を示す斜視回で、第

(3)

第6図はこれら2つのフレーム(2)(4)を位置決め穴(10a)と(10b)、(11a)と(11b)とで一致させ、 発光素子(7)と受光素子(8)とを同い合わせて組合わせた場合の射視図である。

ホトカブラで重要なのは発光祭子(7)と受光衆子(8) との距離であり、とれが短かすぎるとホトカブラ の入力強子(2a)(2b)と出力強子(4a)(4b) (4c)間の絶縁前力がは下し、長寸ぎると発光象 子(7)で発生した光が受光象子(8)にりまく伝達しな くなり、質気信号の伝達率が懸くなる。そのため にこの発明によるホトカブラでは組立設階で、入 力強子フレーム(2)と出力強子フレーム(4)とを発光、 受光部をはさむ両側で固定し、発光、受光部を樹 脳對止するようにしている。

また全てのフレーム及び端子は1つの平面上に並べられているから、対止用樹脂(5)をモールドするための全型も複雑な割型を作る必要はなく、2分割の一般的な金型でよい。

さらにホトカプラでは交先素子(b) 歯の荷女電力を 大きくしたい場合、交先素子(b)の最高使用温度が

特開 昭53- 68992(2) 4 図はその平面区(a)、正面区(b)、角面区(c)である。 図において、(6)はホトカブラ内部で発生した熱を 外部あるいは外部放熱フインに伝達放無するため の放然フインである。そして入力端子(2a)(2⁻ b) は本体の両衡から各1本づつ海出され放動フ イン(6)とは反対方向に折り曲げられ、また出力点 子(4a)(4b)(4c)は放熱フイン(6)とは反対個 から導出されている。とれら入力な子(2a)(2 b)と出力端子(4a)(4b)(4c)は同一平面上 に導出されているため、プリント基板上で一級上 に並べて実長でき、実装面枝を小さくすることが できる。しかも入出力強子間に必要を絶縁沿面距 無をとることができる。 第5回は上述したようた ホトカプラを封止用樹脂(5)でモールドする前の状 您を示す斜視図で、発光衆子(7)が装着された入力 端子フレーム(2)と、受光祭子(8)が装好された出力 端子フレーム(4)とが別々になつている。図で(9 a) (9b) (9c) は内部接続リード線、(10a) (10b)(11a)(11b)は位置決め用のフレーム穴で

14

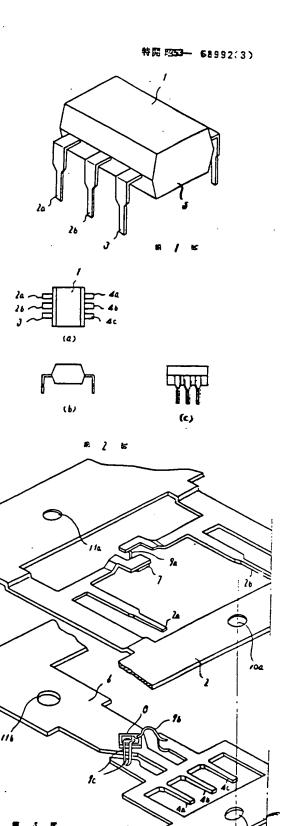
100°c~ 150°c と限られているため、受光素子(8)を冷却しなければならない。 このため受光素子(8)を萎増した出力輝子フレーム(4)を大きくして放熱フィン(6)を形成し、出力囃子(4m)(4b)(4c)の反対僻から外部に出して冷却効果を高めるようにしている。 これとは逆に発光素子(7)をより冷却したい場合には発光禁子(7)を放熱フィン(6)に装着可能である。

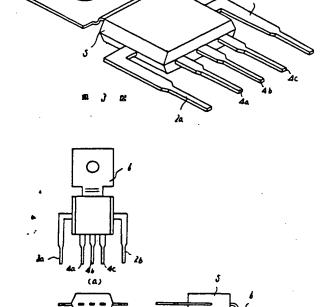
以上のようにとの発明によれば実装面核が小さく、大きな魅力を得致できるホトカブラが得られ、またその発光数子と受光数子間の絶縁矩阵を正確に保つことができるなど多くの効果を有するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のホトカプラを示す外視図、第2 図はその平面図(a)、正面図(b)、何面図(c)、第3図 はこの発明の一実施例を示す針視図、第4図はそ の平面図(a)、正面図(b)、質面図(c)、第5図、第6 図は第3図のものと製作工程を示す針視図である。 図中、(2)は入力障子フレーム、(2a)(2b)は 入力端子、(4)は出力端子フレーム、(42)(4b) (4c)は出力端子、(5)は對止用問題、(6)は放熟フイン、(7)は発光素子、(8)は受光象子である。 、なお眩中同一符号は同一または相当する部分を示す。

代理人 寫 對 佰 一 (他1名)





(C)

-515-

(7)